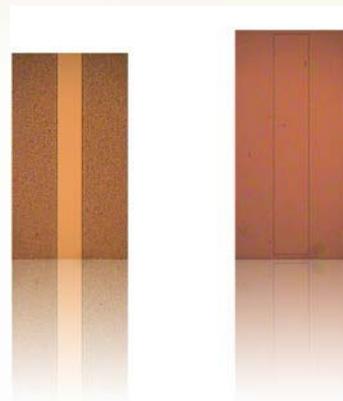


808nm1W 系列芯片

产品简介

808nm 半导体激光器芯片可封装在标准 C-Mount 形式的热沉上，或散热效果优于该封装形式的热沉上，可用于医疗照射、目标指示、激光显示、科学研究等方面。



技术指标 (25°C)

808nm 系列芯片			
参 数		单 位	CLDM-0808-001W
光学参数	输出功率 P_o	mW	1000
	中心波长 λ_c	nm	808 ± 5
	光束发散角 $\theta_{\perp} \times \theta_{\parallel}$	deg	38x10
	COD	W	≥ 2.00
芯片尺寸	发光区宽度	μm	100
	周期	μm	500
	腔长	μm	900
电学参数	斜率效率 E_s	W/A	≥ 1.00
	阈值电流 I_{th}	A	≤ 0.24
	工作电流 I_f	A	≤ 1.25
	工作电压 V_f	V	≤ 2.00





海特光电有限责任公司
Hi-Tech Optoelectronics Co.,Ltd.

- 1、产品型号说明：CLDM (产品类型) -**** (中心波长) -**** (输出功率)。
- 2、上述表中涉及到的参数均在 25°C 下测试获得。
- 3、上述表中涉及到的参数均为在 C-Mount 封装形式下测试获得。
- 4、如有更多信息需求请联系海特光电有限责任公司。



地址：北京市昌平区沙河工业园区海特光电有限责任公司
电话：010-60769887/72 传真：010-60769887-699
网址：www.htoe.com.cn 邮箱：sales@htoe.com.cn

